

2016. 12. 22

SK 하이닉스 000660

SK 하이닉스 클린룸 증설계획 발표

반도체/디스플레이

Analyst 김선우
02. 6098-6688
sunwoo.kim@meritz.co.kr

SK하이닉스 클린룸 증설 계획 발표

SK하이닉스는 금일 오전 공시를 통해 청주와 중국 Wuxi에 각각 2.2조원, 0.9조원의 클린룸 확장 계획을 밝힘. 두 Fab의 증설 기한은 각각 2Q19와 1Q19로서 NAND와 DRAM을 생산할 계획임. 투자계획의 세부 내용은 아래와 같이 추정됨.

청주 (2.2조원): NAND 생산 Fab으로서 M14와 비슷한 1만평 부지에 2층짜리 건물로 건설 예정임. 금번에 발표된 2.2조원은 일부 부지매입과 인프라투자, Shell 건립에 1층 클린룸 투자까지 포함하는 내용임. 19년에 양산될 3D NAND 임을 감안 시 어떤 적층구조를 기반으로 양산됨에 따라 Capa는 유동적임.

Wuxi (0.9조원): DRAM 생산 Fab으로서 기존 C2를 증축하는 투자임. 미세공정이 진행됨에 따라 지속적으로 발생하는 Capa의 자연소실분을 보충하기 위한 투자로 이해. 해당 Fab이 건립되는 2019년에도 현재와 비슷한 280k-290k/월의 DRAM 양산 Capa를 유지하기 위한 공간확보 차원임.

설비투자 계획이 주는 시사점

현재 극심한 공급부족을 겪고 있는 DRAM 및 NAND 업황이 즉각적인 투자 경쟁으로 반전될 수 있다는 확대 해석은 경계해야 한다는 판단. 이는 1) 청주 증설분은 3D NAND 양산 목적으로 향후 연평균 40-50% 이상 수요가 증가가 예상되는 해당 시장을 감안 시 과도한 수준이 아니며, 2) Wuxi 역시 양산 공간 확장 차원일 뿐 해당 투자만으로 17-18년에 Capa 확장이 발생하지는 않기 때문임. 2년 후 양산 공간의 필수 증분을 채우는 투자 발표분이기때문에 현재 진행되고 있는 견조한 메모리 업황에 미치는 영향은 매우 제한적이라는 판단임.

당사는 금번 투자발표와 무관하게, DRAM의 경우 업황의 변곡점은 다음의 여러 조건 중 다중조건이 일치할때 발생 가능하다는 기존의 시각을 유지함. 1) DRAM 판가 상승이 추가진행되며 삼성전자의 DRAM 영업이익률이 50-60% 이상 영역에 위치하고, 2) 마이크론 또는 SK하이닉스가 1Q17 또는 2Q17에 시장 예상을 능가하는 출하량 증가를 시험하며, 3) 매크로 요인에 의해 중국 또는 미국의 Mobile/PC 출하량이 기대치를 하회하는 경우.

Compliance Notice

본 자료는 작성일 현재 사전고지외 관련 사항이 없습니다. 당사는 본 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 2016년 12월 22일 현재 본 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월 간 주권사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2016년 12월 22일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조사분석 담당자는 2016년 12월 22일 현재 본 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김선우)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.